

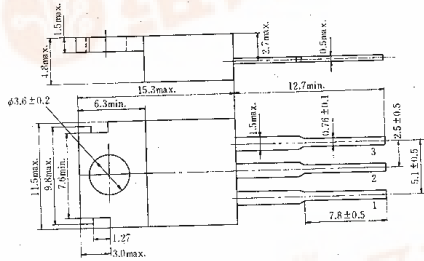
# 2SC1722

2SC1722 供应商

捷多邦, 专业PCB打样工厂, 24小时加急出货

シリコン NPN 三重拡散 LTP 形  
低周波電力増幅用  
TV 水平, 垂直励振用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED LTP  
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER  
TV HORIZONTAL/VERTICAL DRIV.



1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector  
(フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter  
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-220AB)

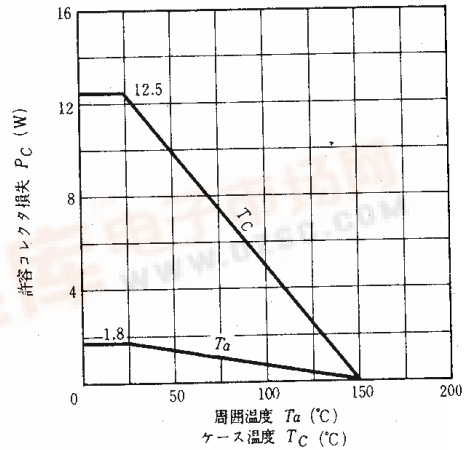
## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

項	目	Symbol	2SC1722	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$		300	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$		300	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$		5	V
コレクタ電流	$I_C$		0.2	A
許容コレクタ損失	$P_C^*$		12.5	W
許容コレクタ損失	$P_C$		1.8	W
接合部温度	$T_j$		150	$^{\circ}\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$		-45~+150	$^{\circ}\text{C}$

\*  $T_c=25^{\circ}\text{C}$  における許容値

\* Value at  $T_c=25^{\circ}\text{C}$

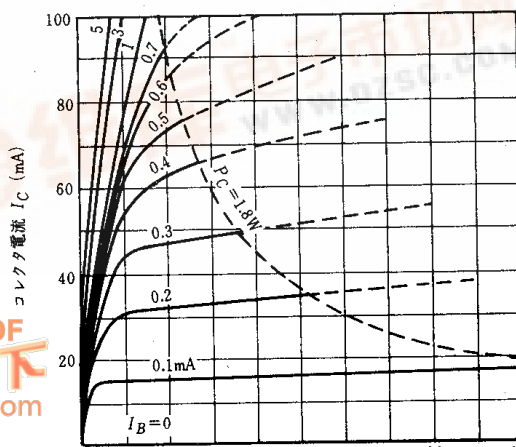
## 許容コレクタ損失の周囲温度、 ケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$		$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$		$I_C=5\text{mA}, R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$		$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$		$V_{CB}=250\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	$\mu\text{A}$
	$I_{CEO}$		$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	2	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$		$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	50	—	300	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$		$I_C=50\text{mA}, I_B=5\text{mA}$	—	1.0	2.0	V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$		$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	—	0.68	0.9	V
利得帯域幅積	$f_T$		$V_{CE}=20\text{V}, I_C=30\text{mA}$	—	80	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$		$V_{CB}=50\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	4.3	6.0	pF

## エミッタ接地出力静特性 TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS



## エミッタ接地伝達静特性 TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS

